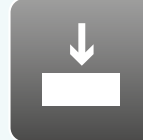
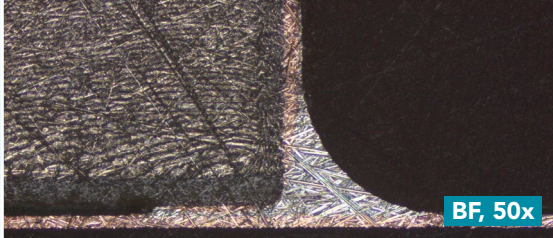
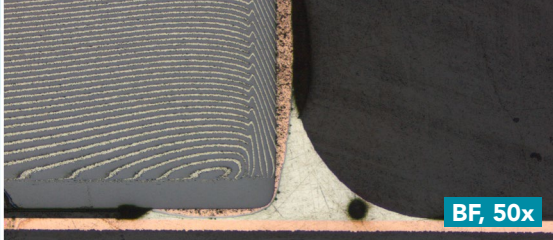
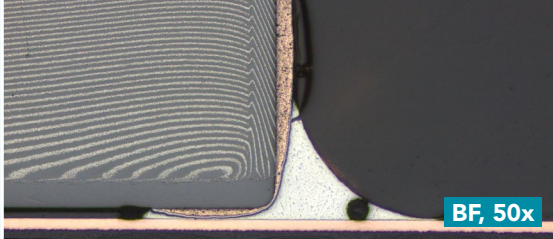


Aka-Brief #13 电子元器件

1	 Rhaco Grit P320	 水	 300 RPM	 20 N	 磨平	 BF, 50x
2	 Largan 9	 DiaUltra 9 µm	 150 RPM	 30 N	 3 min	 BF, 50x
3	 Daran	 DiaUltra 3 µm	 150 RPM	 25 N	 3 min	 BF, 50x
4	 Chemal*	 Fumed Silica 0.2 µm Alkaline**	 150 RPM	 15 N	 2 min	 BF, 50x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

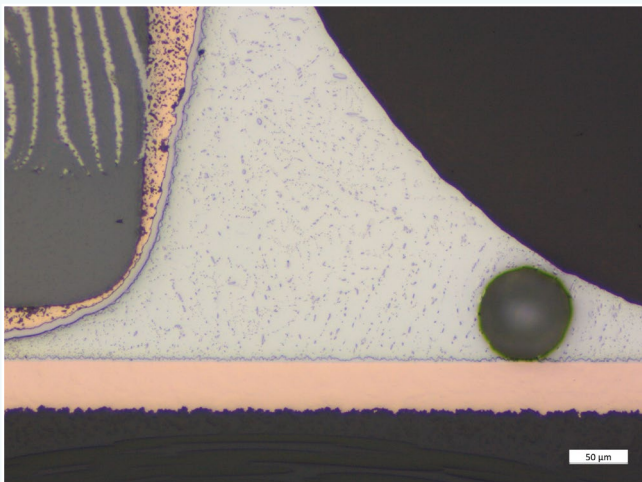
*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

**96毫升 Fumed Silica,
2毫升 H₂O₂ (30%),
2毫升 NH₄OH (25%).

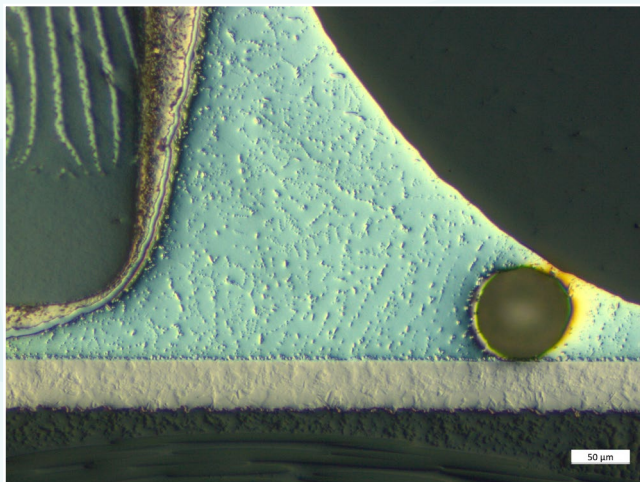
这种混合物应该在使用新鲜时（几个小时之内），并定期搅拌。

Aka-Brief #13 电子元器件

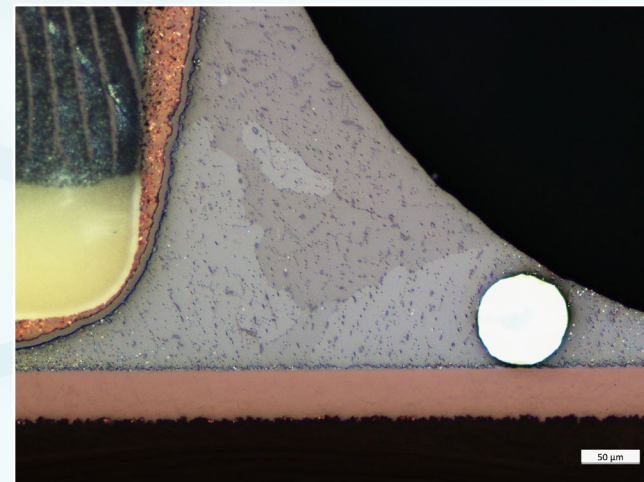
最终制样结果



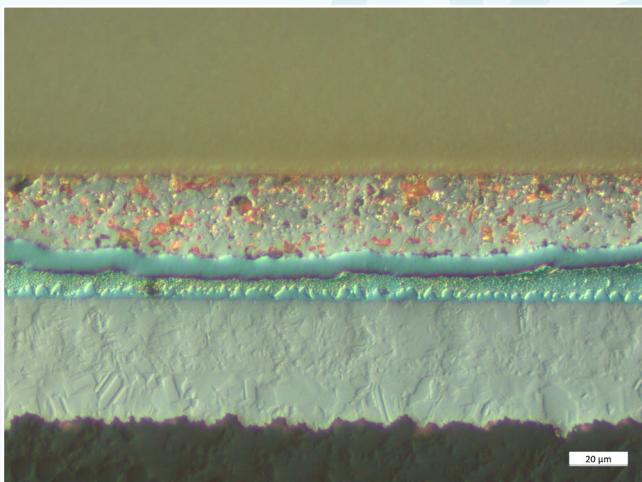
明场像，200倍



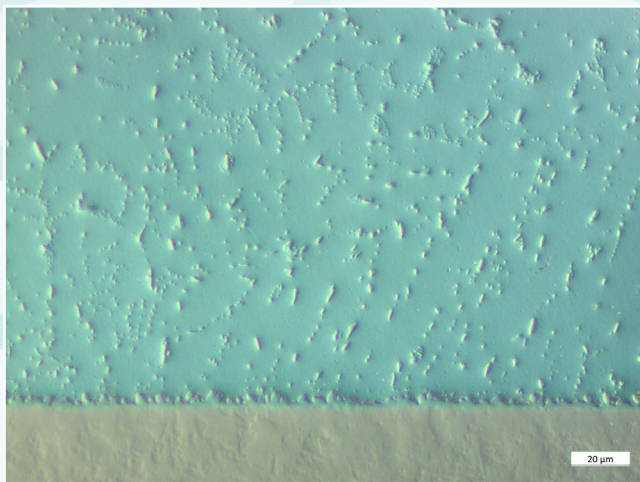
微分干涉衬度像，200倍



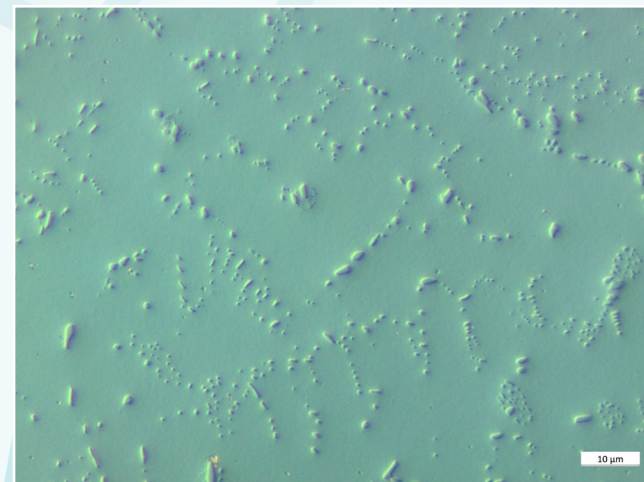
偏正光+Lambda补偿片，200倍



微分干涉衬度像，500倍



微分干涉衬度像，500倍



微分干涉衬度像，1000倍